

令和元年 11 月 26 日  
国際戦略局技術政策課  
研究推進室

平成 26 年度～平成 30 年度「テラヘルツ波デバイス基盤技術の研究開発  
-300GHz 帯シリコン半導体 CMOS トランシーバ技術-」  
に係る取得資産の需要調査結果

1. 概要

平成 26 年度～平成 30 年度「テラヘルツ波デバイス基盤技術の研究開発-300GHz 帯シリコン半導体 CMOS トランシーバ技術-」に係る取得資産の処分に当たって、公募による需要調査を実施した（調査期間：11 月 15 日～11 月 25 日）。

上記の需要調査の結果、購入希望者がいなかったことを確認した。

2. 取得財産の処分について

需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

連絡先  
国際戦略局  
技術政策課研究推進室  
TEL : 03-5253-5730  
FAX : 03-5253-5732